

## (12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

<p>(21) เลขที่คำขอ 0901002164 (22) วันที่ยื่นคำขอ 15 พฤษภาคม 2552</p>	<p>(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 C01B 3/24</p>
<p>(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก - (32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก - (33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก -</p>	<p>(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>(72) ผู้ประดิษฐ์ นายโอภาส ตรีทวีศักดิ์ และคณะ</p> <p>(74) ตัวแทน นางสาวอรุณศรี ศรีชนะอิทธิพล และ/หรือ นายชาญชัย นีรพัฒน์กุล และ/หรือ นางสาวอรกนก พรธรรมรักษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120</p>
<p>(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์</p>	<p>"วิธีการสร้างขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบจุลภาค"</p>
<p>(57) บทสรุปการประดิษฐ์</p>	<p>การประดิษฐ์นี้เป็นการสร้างขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบจุลภาค โดยใช้เทคนิคการกัดแบบพลาสมาอย่างลึก (Deep Reactive Ion Etching) ให้เกิดเป็นช่องสำหรับเติมสารละลายในแผ่นซิลิกอน และใช้ฟิล์มฉนวนบางแบบแขวนลอยทำหน้าที่เป็นเยื่อหรือเมมเบรนให้น้ำในสารละลายแพร่ผ่านได้</p>